

# **XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОТОЭЛЕКТРОНИКЕ И ПРИБОРАМ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ**

29, 30, 31 Мая 2024 г. • Москва, Россия

## **ПРОГРАММА СЕКЦИИ**

Статус: **утверждена**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НПО "ОРИОН"**

Москва, 2026

# **Общая информация**

## **Время и место проведения**

Конференция проводится 29, 30, 31 Мая 2024 г. в АО «НПО «Орион»: Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

## **Проезд на конференцию**

Метро Выхино (или железнодорожная станция Выхино).

Из метро выход № 4 (на улицы Красный Казанец, Вешняковская, Косинская)

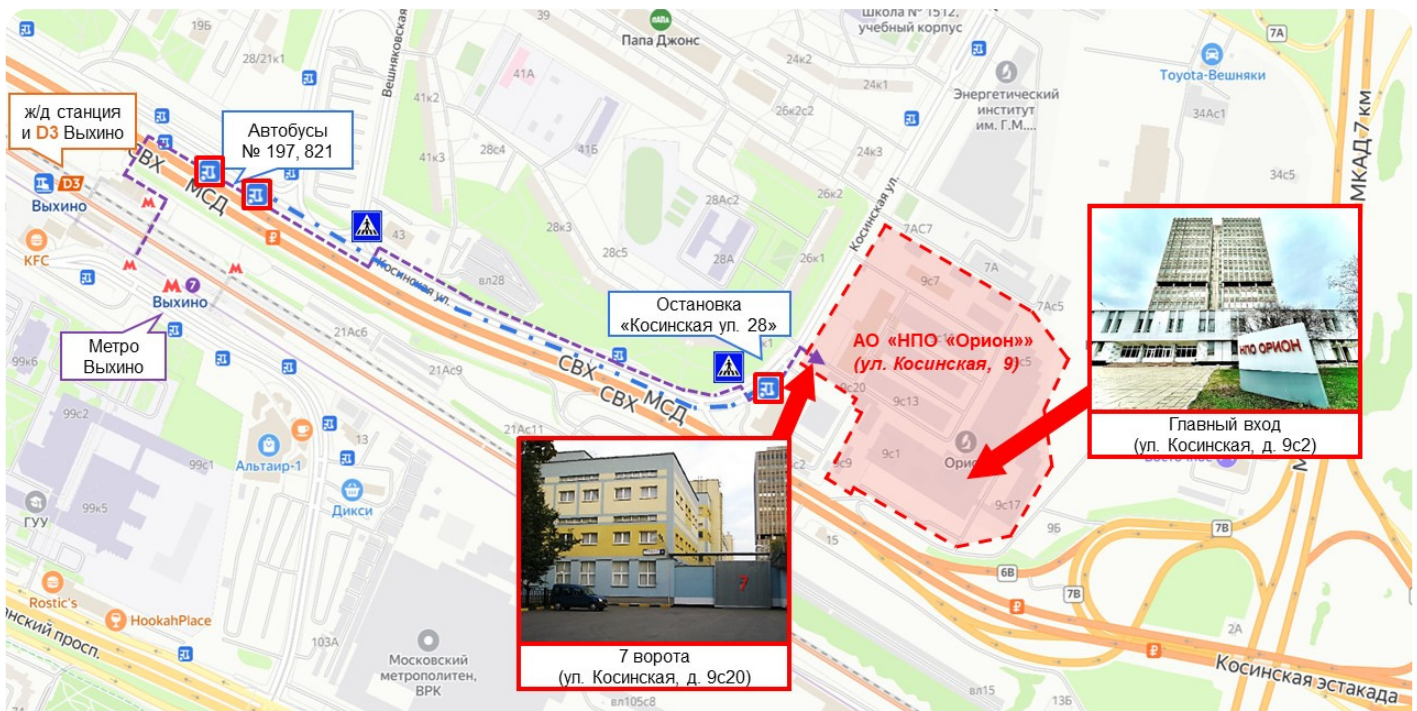
С железнодорожной станции выход через подземный переход (на улицы Красный Казанец, Вешняковская, Косинская)

Пройти через туннель под Северо-Восточной хордой, свернуть направо к автобусной остановке.

Автобусы 197, 821 до остановки Косинская ул., 28 (одна остановка).

Выйдя из автобуса, пройти вперёд вдоль Косинской улицы до проходной АО «НПО «Орион».

Или пройти пешком от метро (или ж/д станции) Выхино вдоль Косинской улицы (около 1 км). Сначала перейти Косинскую улицу на перекрестке с Вешняковской улицей, далее идти в сторону Косинской эстакады. У автобусной остановки снова перейти Косинскую улицу и идти до проходной АО «НПО «Орион».



## 31 мая / 3 день

### 09:00 Секция 5. Материалы фотосенсорики и методы их получения. Заседание 1 (Зал 1)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ (НАЧАЛО В 09:00) • ЗАЛ 1, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ • ДОКЛАДЫ: 11 • ПЯТНИЦА, 31 МАЯ (НАЧАЛО В 09:00)

#### 09:00 Базовая технология полирования пластин InSb для эпитаксиального роста фоточувствительных материалов методом МЛЭ

Устный • Улькаров Вадим Айратович • АО "НПО "ОРИОН"

#### 09:15 Подложки CdZnTe для эпитаксиального выращивания твердых растворов A<sub>2</sub>B<sub>6</sub> методом МЛЭ

Устный • Трофимов Александр Александрович • АО "НПО "ОРИОН"

#### 09:30 Разработка промышленно-ориентированной технологии изготовления полированных пластин InSb диаметром до 100 мм

Устный • Козлов Роман Юрьевич • ГИРЕДМЕТ

**09:45 К вопросу о канальной неоднородности в монокристаллах InSb(Te), выращенных в различных кристаллографических направлениях**

Устный • Комаровский Никита Юрьевич • ГИРЕДМЕТ

**10:00 Некоторые тенденции развития технологий выращивания объемных кристаллов фотоники**

Устный • Наумов Аркадий Валерьевич • ОКБ "АСТРОН"

**10:15 Исследование 100 мм пластин Ge, предназначенных для эпитаксиальных процессов**

Устный • Малыгин Владислав Анатольевич • АО "НПО "ОРИОН"

**10:30 Структурные и оптические свойства InAs/GaSb сверхрешеток полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии**

Устный • Ерошенко Григорий Николаевич • ФИАН

**10:45 Спектроскопия сульфидов олова и европия, синтезированных при высоком давлении**

Устный • Николаев Сергей Николаевич • ФИАН

**11:00 Исследование влияния постростового отжига на дислокационную структуру кристаллов германия**

Устный • Григорович Андрей Павлович • ГЕРМАНИЙ

**11:15 Моделирование и оптимизация электрооптического эффекта в модуляторе Маха-Цендера на технологической платформе InP**

Устный • Гришаков Константин Сергеевич • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

**11:30 Исследование влияния различных бром-содержащих компонентов при получении чернил ККТ HgSe на свойства фотосенсоров на их основе**

Хакимов Карим Тимурович • МФТИ, ФИЗТЕХ